

USAMI

U.S. Patent Application No. 10/765,094

Our Ref.: 8022-1067

1. Since the invention relating to the following claims of the present application is an invention described in the following publications, which were in circulation in Japan or abroad prior to the submission of the present application, or is an invention which could have been publicly used through electric communication lines, therefore, in accordance with Patent Law Article 29 Section 1, No. 3, a patent may not be granted.

2. The invention relating to the following claims of the present application could easily have been invented prior to the present application by a person of ordinary skill in the field of technology pertaining to the invention, based on the invention described in the following publications, which have been in circulation in Japan or abroad prior to the present application, or which could be publicly used through electric communication lines. Therefore, in accordance with Patent Law Article 29 Section 2, a patent may not be granted.

Record (See the Reference Citation List to obtain the citation)

Claim 1, and 5-7

Reasons 1 and 2

Citations 1 and 2

Remarks:

Particular reference is made to Figure 2 and the related explanatory section of Citation 1.

Particular reference is made to Figure 3 and the related explanatory section of Citation 2.

In addition, in Citation 1, no reference is made to a changing quality layer. However, as a result of executing a groove formation process, the form of the changing quality layer is anticipated as being the result of relative thickness, rather than being due to the upper process or the lower process.

At the present time, no grounds for rejection have been found with respect to the invention relating to claims other than those specified within the written Notice of Grounds for Rejection. In the event that further reasons for rejection are discovered in the future, you will be notified of such reasons.

Reference Citation List

1. Patent Table 2003-533025
2. Japanese Laid Open Patent Publication 2002-110644

整理番号:74112742

発送番号:040469 発送日:平成17年 2月 8日

1

拒絶理由通知書

特許出願の番号	特願 2 0 0 3 - 0 1 9 4 1 1
起案日	平成 1 7 年 2 月 1 日
特許庁審査官	大嶋 洋一 9 1 7 0 4 L 0 0
特許出願人代理人	徳丸 達雄 様
適用条文	第 2 9 条第 1 項、第 2 9 条第 2 項

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものである。これについて意見があれば、この通知書の発送の日から 6 0 日以内に意見書を提出して下さい。

理 由

1. この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記 of 刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明であるから、特許法第 2 9 条第 1 項第 3 号に該当し、特許を受けることができない。

2. この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前日本国内又は外国において頒布された下記 of 刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第 2 9 条第 2 項の規定により特許を受けることができない。

記 (引用文献等については引用文献等一覧参照)

<請求項 1、5～7 について>

- ・理由 1, 2
- ・引用文献 1, 2
- ・備考

引用文献 1 の、特に第 2 図及びその説明箇所を参考のこと。

引用文献 2 の、特に第 3 図及びその説明箇所を参考のこと。

また、引用文献 1 には、変質層に関して明記していないが、溝形成プロセスを施した結果として、変質層の形状は加工上部で加工下部よりも相対的に厚くなることが予想され得る。

この拒絶理由通知書中で指摘した請求項以外の請求項に係る発明については、現時点では、拒絶の理由を発見しない。拒絶の理由が新たに発見された場合には拒絶の理由が通知される。

整理番号:74112742 発送番号:040469 発送日:平成17年 2月 8日 2/E

引用文献等一覧

1. 特表2003-533025号公報
2. 特開2002-110644号公報

先行技術文献調査結果の記録

・調査した分野 I P C 第7版
 H 0 1 L 2 1 / 3 2 0 5 , H 0 1 L 2 1 / 3 2 1 3
 H 0 1 L 2 1 / 7 6 8
 H 0 1 L 2 1 / 2 8 - H 0 1 L 2 1 / 2 8 8
 H 0 1 L 2 9 / 4 0 - H 0 1 L 2 9 / 5 1

この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではない。

<参考情報>

今回の拒絶理由において、各引用文献、先行技術文献等の、主にどのような技術的ポイントに着目しているかについて、参考情報として示します。意見書・補正書作成の際、参考情報としてご利用ください。

ただし、下記ポイントは、引用文献の一部の記載について例示的に示したに過ぎず、拒絶理由の対象となる範囲は、この記載に限定されず、あくまでも引用文献に記載された全範囲である点について、留意してください。

引用文献1：半導体基板上にHSQ膜を成膜し、C₄F₈とO₂を用いドライエッチングする製造プロセス技術。

引用文献2：同上。

また、先行技術調査をする際、利用した代表的な検索条件（Fターム、キーワード等）を示します。本願発明の認定に関して、適切な認定が行われているかを確認するための参考情報等としてご利用下さい。

Fターム：5F033TT08, 5F033QQ15

キーワード：HSQ(Hydrogen SilisesQuioxane)

この拒絶理由通知の内容に関するお問い合わせ(例：引用文献の番号違い等)、または技術説明等の面接の御希望がございましたら下記までご連絡下さい。

特許審査第三部 半導体集積回路

審査官 大嶋 洋一

TEL. 03(3581)1101 内線3498

FAX. 03(3501)0673